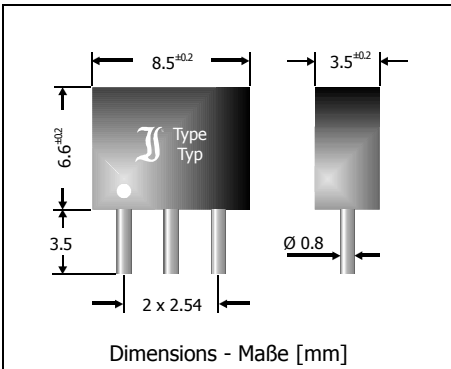
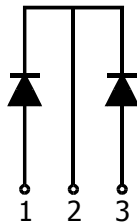


**DAN208 / DAP208 (1.2 W)**  
**Silicon-Twin Rectifiers – Center Tap**  
**Silizium-Doppeldiode – Mittelpunktschaltung**

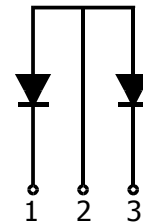
Version 2008-04-15



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	150 V
3-pin Plastic case 3-Pin Kunststoffgehäuse	8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.7 g
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



"DAN" common cathodes / gemeinsame Kathoden



"DAP" common anodes / gemeinsame Anoden

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V] <sup>1)</sup>
DAN208	100	150
DAP208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	$1\text{ A}^{2)}$ $2\text{ A}^{2)}$
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb beider Dioden	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	$1\text{ A}^{2)}$ $2\text{ A}^{2)}$
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	10/11 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	$-50\dots+150^\circ\text{C}$ $-50\dots+150^\circ\text{C}$

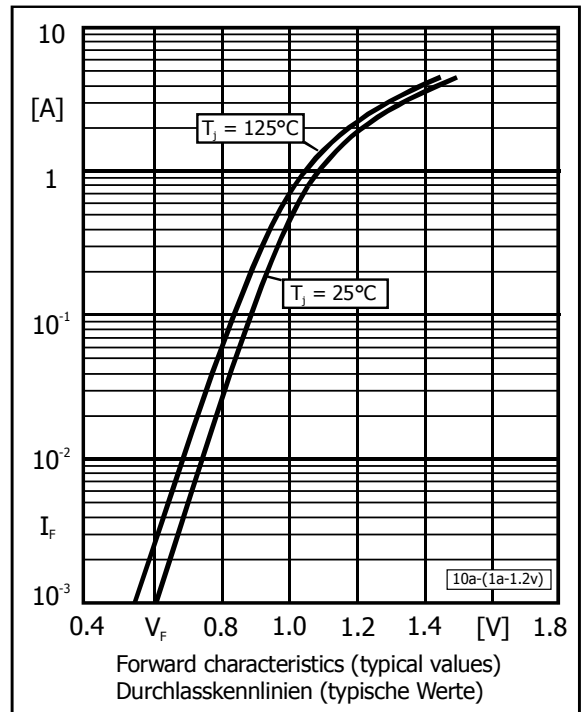
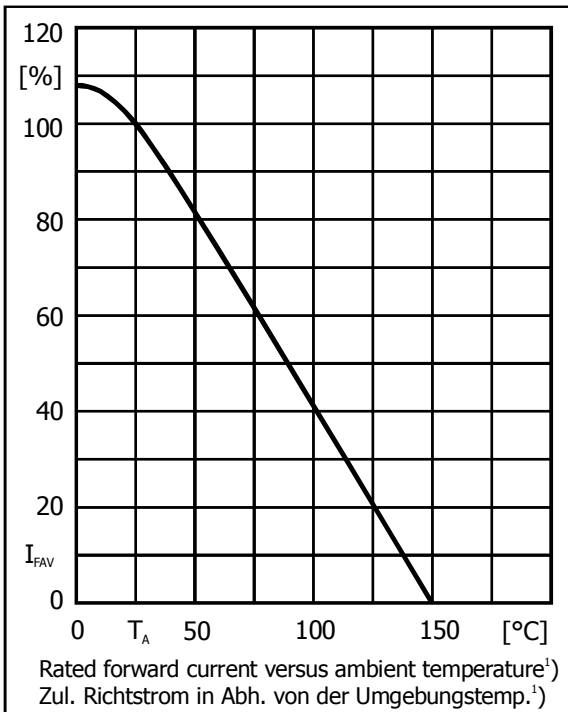
1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 1\text{ A}$	$V_F$	$< 1.2\text{ V}^1)$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 100\text{ V}$	$I_R$	$< 10\ \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		$R_{thc}$	$< 45\text{ K/W}^2)$



1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden